

法政大学イオンビーム工学研究所報告
No. 40. 2019年度 目次

(出版者 / Publisher)

法政大学イオンビーム工学研究所

(雑誌名 / Journal or Publication Title)

Report of Research Center of Ion Beam Technology, Hosei University / 法政
大学イオンビーム工学研究所報告

(巻 / Volume)

40

(発行年 / Year)

2021-02-26

法政大学イオンビーム工学研究所報告

No.40 2019

目 次

1. 研究ノート

5. 高破壊耐量GaN p-n接合ダイオードの研究

…………… 太田 博、浅井 直美、三島 友義 (14)

6. エピタキシャルグラフェンのリンクル構造と磁性との相関

…………… 青木 涼真、勝俣 瞬、石黒 康志、高井 和之 (18)

9. Observation of the distortion around Ga lattice sites

due to the residual hydrogen in GaN single crystal wafer

…………… Kazuki Sato, Tomoaki Nishimura, Kazuo Kuriyama, Tohru Nakamura (28)

2. 第38回法政大学イオンビーム工学研究所シンポジウム …………… (31)

3. 年間事業報告 …………… 西村 智朗 (37)

4. 研究の現状 …………… (39)

5. 研究成果発表論文リスト …………… (41)

6. 研究所組織 …………… (56)

編集後記 …………… (57)